溶融および焼結 ScAI 合金ターゲットを用いた高品質な ScAIN 薄膜の作製

High quality ScAlN films grown by using

arc-melted and sintered ScAl alloy target sputtering

早稲田大学 ¹,材研 ²,JST さきがけ ³,名古屋工業大学 ⁴,株式会社フルヤ金属 ⁵

○白 寧蕊 1,2, 唐澤 嶺 1,2, 高柳 真司 4, 今川 誠 5, 森坂 啓介 5, 鈴木 雄 5, 柳谷 隆彦 1,2,3

Waseda Univ. 1, ZAIKEN2, JST PRESTO3, Nagoya Inst. Tech. 4, FURUYA METAL CO., Ltd. 5

°Ningrui Bai^{1,2}, Rei Karasawa^{1,2}, Shinji Takayanagi⁴, Makoto Imakawa⁵, Keisuke Morisaka⁵,

Yu Suzuki⁵, and Takahiko Yanagitani^{1,2,3}

E-mail: haku_neizui@ruri.waseda.jp

える。

1. まえがき

圧電薄膜は移動体通信フィルタに応用され ている。フィルタの帯域幅は圧電材料の電気機 械結合係数で決まる。2008年に、秋山らはAIN に Sc をドープした ScAIN 薄膜おいて巨大な圧 電性を発見している。ScAIN 薄膜は広帯域フィ ルタへの応用が期待されている。

ScAIN 薄膜の作製法として、Sc 粒を AI ター ゲットに置く方法や ScAl 合金ターゲットを用 いる成膜方法などが報告されている。Sc の表 面は酸素が多く含まれるので、作製した薄膜の 結晶性が劣化し、k2値も低くなることがある。 成膜中の結晶性の劣化を防ぐために、ターゲッ トを改善し、高結晶性と高 k_t^2 値の ScAIN 薄膜 を作製することを本研究の目的とする。

2. ScAIN 薄膜の作製と測定

本研究では、三種類のターゲットを用いて、 一元スパッタ法で ScAIN 薄膜を作製した。一 つ目は、比較としてSc粒をAlターゲットに配 置したターゲットを準備した。二つ目は、ScAl アーク溶融合金である。これはアーク溶解によ り真空溶融したものであり、酸素濃度が少ない 利点がある。三つ目は焼結 ScAl 合金で、ガス アトマイズ法により作製した粉体を焼結した ものである。酸素濃度がアーク溶融法より高く なるが、大型のターゲットを作製できる利点が

ターゲットに含まれる不純物は赤外線吸収 法により評価した。溶融ターゲットに含まれて いた不純物の酸素は900 ppm、炭素は50 ppm であった。焼結ターゲットに含まれていた酸素 は8000 ppm、炭素は300 ppm であった。

酸素負イオンの影響を低減のため、成膜前に 長時間のプレスパッタを行った。成膜中ターゲ ットから出る酸素負イオンの照射量は四重極 質量分析計付エネルギーアナライザで測定し

作製した ScAIN 薄膜の結晶性は X 線回折装 置(XRD) により評価した。三種類のターゲッ トで作製した試料の(0001)ωロッキングカーブ 半値幅は全て 2.0° 程度で、良好な結晶性とい

3. ScAIN 薄膜の圧電性の評価

薄膜に上部電極として金を真空蒸着し、共振 子を作製した。ネットワークアナライザで変換 損失を測定し、Mason 等価回路モデルにより計 算した変換損失の理論値と比べて、kt2 値を算 出した。

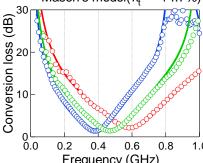
Sc 粒で作製した薄膜の k^2 値は 14.7%であっ た。アーク溶融合金で成膜した ScAIN 薄膜の k_t^2 値は 22.0%であった。 焼結合金で成膜した薄 膜の k_t^2 値は20.1%であった。

4. まとめ

アーク溶融合金と焼結合金ターゲットで成 膜した ScAIN 薄膜は Sc 粒を使ったものに比べ てより高い k_t2値を得た。焼結合金の酸素濃度 が高いが、アーク溶融合金と比べて同じ程度の k_t^2 値となった。

- Arc-melted ScAl alloy target
- Mason's model($k_t^2 = 22.0\%$)
- Sintered ScAl alloy target
- Mason's model($k_t^2 = 20.1\%$)
- Sc ingots with Al plate target

Mason's model($k_t^2 = 14.7\%$)



Frequency (GHz) Figure 1. Experimental and theoretical conversion loss curves of ScAlN films made by Arc-melted ScAl alloy target, sintered ScAl alloy target, and Sc ingots with pure Al plate target. The theoretic Al curves were simulated by Mason's equivalent circuit model including the electrode layers.